

<i>Долгов А.С., Валуйская А.В.</i> Миграция взаимодействующих атомов в поверхностном монослое	144
<i>Зубко Є.І.</i> Функціоналізація і наноструктурування поверхневих шарів поруватого кремнію	154
<i>Каверин М.В., Krause-Rehberg R., Береснев В.М., Постольный Б.А., Колесников Д.А., Якущенко И.В., Билокур М.А., Жоллыбеков Б.Р.</i> Влияние дефектов и примесных атомов на физико-механические свойства наноструктурных покрытий в области границ их раздела	160
<i>Кудринський З.Р.</i> Топологія поверхні тонких оксидних плівок CdO, сформованих на ван-дер-ваальсових поверхнях шаруватих кристалів InSe TA GaSe	185
<i>Дадамирзаев М.Г.</i> Разогрев электронов и дырок в несимметричном <i>p-n</i> -переходе, находящемся в СВЧ поле	191
<i>Гулямов Г., Шарипбаев Н.Ю., Эркабоев У.И.</i> Влияние эффективной массы плотности состояний на температурную зависимость ширины запрещенной зоны в твердых растворах $p\text{-Bi}_{2-x}\text{Sb}_x\text{Te}_{3-y}\text{Se}_y$	195
<i>Їдгорова Д.М., Каримов А.В., Каримов А.А.</i> Исследование процессов модуляции базовой области кремниевой $p^+p\text{-}n^+$ -структуры	199
<i>Береснев В.М., Турбин П.В., Грудницкий В.В., Торьяник И.С., Дмитренко А.Е., Кропотов А.Ю., Гриценко В.И., Маликов Л.В., Гранкин С.С.</i> Применение многокомпонентных катодов, полученных электронно-лучевым плавлением, для формирования сверхтвердых наноккомпозитных покрытий	204
<i>Олимов Л.О., Муйдинова М., Омонбоев Ф.Л.</i> Электрические свойства межзеренных границ в объеме поликристаллического кремния	212
<i>Мирсагатов Ш.А., Ачилов А.С., Заверюхин Б.Н.</i> Тонкопленочные детекторные CdTe-структуры с барьером Шоттки	216
<i>Сапаев И.Б.</i> Исследование электрических и фотоэлектрических свойств In-CdS _x Te _{1-x} -Si-In структуры	223
<i>Шарипбаев Н.Ю.</i> Исследования температурной зависимости ширины запрещенной зоны Si и Ge с помощью модели	228
<i>Пилипенко Н.Н., Дробышевская А.А., Ажажа Р.В., Стадник Ю.С., Танцюра И.Г.</i> Термооксидные покрытия на циркониевых материалах	231
<i>Яремій І. П., Томин У. О., Уманців М. М., Кравець В. І.</i> Вплив імплантації іонами гелію на форму елементарної комірки у приповерхневих шарах монокристалів	237
<i>Гулямов Г., Гулямов А.Г., Мажидова Г.Н.</i> Тензорезистивный эффект в системе потенциальных барьеров в полупроводниковых пленках	243
<i>Правила оформлення рукописей</i>	246
<i>Правила оформлення рукописів</i>	247
<i>Information for authors</i>	248